

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К1014КТ1ВПАМ

ОАО «Ангстрем»

124460, г. Москва, Зеленоград

63 3132 6761

ЭТИКЕТКА

ЩИЗ.365.015 '07

ОПЫТНЫЙ

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ К1014КТ1ВПАМ

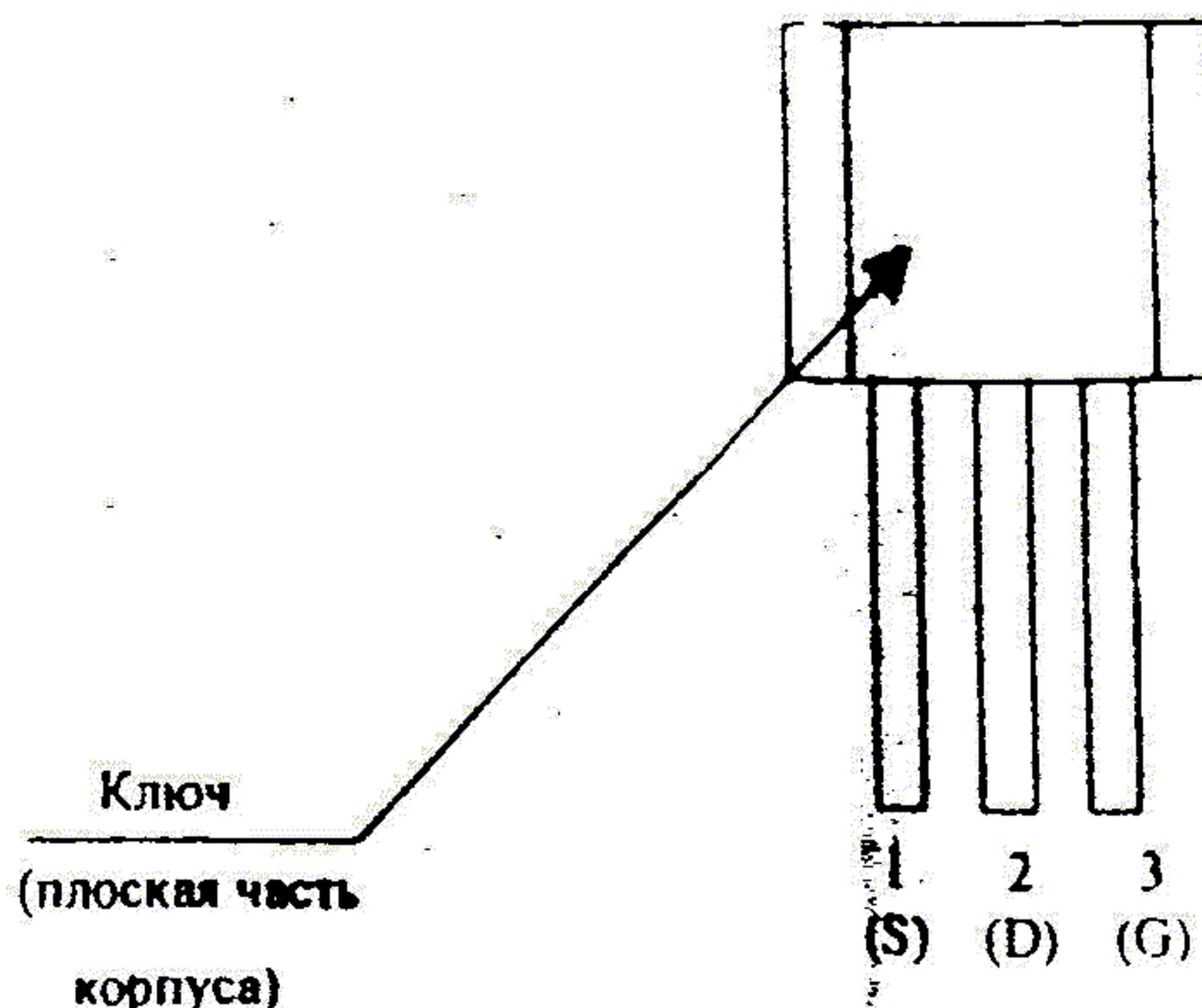
Микросхема К1014КТ1ВПАМ поставляется в пластмассовом корпусе КТ-26

Категория качества – «К»

Климатическое исполнение У категории 3

На микросхемах вместо обозначения К1014КТ1ВПАМ наносится код – «IB»

Схема расположения выводов



• Обозначения выводов приведены условно

(К1014КТ1ВПАМ)

Таблица I – Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхемы К1014КТ1ВПАМ

Номер выводов микросхемы К1014КТ1ВПАМ	Буквенное обозначение	Наименование выводов микросхемы
1	2	3
1	S	Исток
2	D	Сток
3	G	Затвор

I ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры

Таблица 2 – Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначе- ние параметра	Норма параметра		Темпера- тура °C
		не менее	не более	
1	2	3	4	5
1.1 Прямое падение напряже- ния на обратном диоде, В при $I_{DS} = 200 \text{ mA}$, $U_{GS} = 0 \text{ V}$	U_{DSS}	—	1,45	25 ± 10
1.2 Пороговое напряжение, В при $I_{DS} = 0,25 \text{ mA}$, $U_{GS} = U_{DS}$	U_{GSO}	—	1,8*	-45
1.3 при $I_{DS} = 200 \text{ mA}$, $U_{GS} = 0 \text{ V}$			1,45*	70
2.1 Начальный ток стока, мкА при $U_{DS} = 250 \text{ V}$, $U_{GS} = 0 \text{ V}$	I_{DSS}	0.9	1,8	25 ± 10
2.2 при $U_{DS} = 230 \text{ V}$, $U_{GS} = 0 \text{ V}$		—	2,0*	-45
2.3 при $U_{DS} = 260 \text{ V}$, $U_{GS} = 0 \text{ V}$		0.8*	—	70
3.1 Ток утечки затвора, мкА при $U_{GS} = \pm 10 \text{ V}$, $U_{DS} = 0 \text{ V}$	I_{GS}	-10	10	25 ± 10
3.2 при $U_{GS} = 4,5 \text{ V}$		-10*	10*	-45
3.3 при $U_{GS} = 4,5 \text{ V}$		-50*	50*	70
4.1 Коммутируемый ток (постоянный), мА при $U_{GS} = 4,5 \text{ V}$	I_{DS1}	—	200*	25 ± 10
4.2 при $U_{GS} = -4,5 \text{ V}$		—	200*	-45
4.3 при $U_{GS} = +4,5 \text{ V}$		—	200*	70
5 Коммутируемый ток (импульсный), А при $U_{GS} = 4,5 \text{ V}$, $t_i \leq 1,0 \text{ мс},$ $Q \geq 50$	I_{DS2}	—	1*	25 ± 10
6 Время включения, нс при $I_{DS} = 200 \text{ mA}$, $U_{DS} = 50 \text{ V}$, $U_{GS} = 10 \text{ V}$	t_{on}	—	100*	25 ± 10
7 Время выключения, нс при $I_{DS} = 200 \text{ mA}$, $U_{DS} = 50 \text{ V}$, $U_{GS} = 10 \text{ V}$	t_{off}	—	300*	25 ± 10
8 Сопротивление в открытом состоянии, Ом при $I_{DS} = 35 \text{ mA}$, $U_{GS} = 2,5 \text{ V}$	$R_{DS(on)}$	—	8	25 ± 10
9.1 при $I_{DS} = 35 \text{ mA}$, $U_{GS} = 2,5 \text{ V}$		—	10*	-45
9.2 при $I_{DS} = 35 \text{ mA}$, $U_{GS} = 2,5 \text{ V}$		—	—	70

* Параметры гарантируются

Таблица 3 – Пределенно-допустимый и предельный режим эксплуатации микросхем

Наименование параметра единица измерения	Буквенное обозначе- ние	Пределено- допустимый режим		Предельный режим ¹⁾	
		не менее	не более	не менее	не более
1	2	3	4	5	6
Напряжение сток-исток в закрытом состоянии В	U_{DSS}	—	250 ²⁾	—	255
Максимально-допустимое напряжение затвор-исток, В	U_{GSS}	-10	10	-12	12
Коммутируемый ток (постоянный), мА	I_{DS1}	—	200	—	210
Коммутируемый ток (импульсный), А	I_{DS2}	—	1,0	—	1,1
Рассеиваемая мощность, Вт	P_{max}	—	0,35	—	0,5

¹⁾ Параметры не гарантируются²⁾ При температуре корпуса плюс (25 ± 10) °C³⁾ При температуре корпуса минус 45 °C⁴⁾ При температуре корпуса плюс 70 °C

3.2 Содержание драгоценных материалов на 1000 шт.

Серебро

Г.

Серебро

Г.

Вт/ч чистка

Г.

г/мм на 2000 выводах длиной

мм

13 цинковых металлов не содержится

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Наработка микросхем в режимах и условиях, допускаемых АДБК 431160.686 ТУ, должна быть не менее 53000 ч, а в следующих облегченных режимах, в нормальных климатических условиях при $U_{GS} = 2,5$ В, $I_{DS} = 35$ мА - 60000 ч.

2.2 Интенсивность отказов в течение наработки должна быть не более $1 \cdot 10^{-6}$ 1/ч.

2.3 Гамма-процентный срок сохраняемости микросхем при $\gamma = 95\%$ - 10 лет

ЗАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества микросхем требованиям АБДК.431160.686 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и ТУ на данную микросхему.

Гарантийный срок хранения микросхем в соответствии с пунктом 2.3 настоящей этикетки – 10 лет и исчисляется со дня их изготовления.

Гарантийная наработка микросхем в режимах и условиях, допускаемых этикеткой и АБДК.431160.686 ТУ – 50000 ч и 60000 ч в облегченном в соответствии с пунктом 2.1 настоящей этикетки:

- при поставке потребителю – со дня их отгрузки;
- при поставке на экспорт – со дня проследования их через государственную границу РФ.

Гарантийные наработки исчисляются в пределах гарантированного срока хранения.

Гарантийный срок эксплуатации микросхем при поставке их в торговую сеть – 12 месяцев со дня розничной продажи в пределах гарантированного срока хранения.

При несоответствии микросхем требованиям настоящей этикетки и АБДК.431160.686 ТУ претензии по качеству удовлетворяют в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема К1014КТ1В1АМ соответствует техническим условиям АБДК.431160.686 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Приняты по _____ от _____
указывают документ о приемке (извещение, акт и др.) дата

ШТАМП СКК
(индивидуальный или общий) подпись лица, ответственного за приемку
(помещают в случае проставки общего штампа СКК)

ШТАМП «Перепроверка произведена _____»
дата

Приняты по _____ от _____
указывают документ о приемке (извещение, акт и др.) дата

ШТАМП СКК
(индивидуальный или общий) подпись лица, ответственного за приемку
(помещают в случае проставки общего штампа СКК)

Цена договорная

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Указания по применению и эксплуатации микросхем – по ГОСТ 18725.

5.2 Микросхемы чувствительны к воздействию СЭ – допустимое значение потенциала СЭ не более 300 В.

5.3 Электрические режимы эксплуатации, при которых параметры микросхем не регламентируются и за пределами которых микросхема может быть повреждена, приведены в таблице 3 (пределный режим).

5.4 Режим и условия монтажа микросхем в аппаратуре – по ОСТ Г1 073.063.

Микросхема К104К71ВПЛМ пригодна для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ Г1 073.063 для корпуса – схема 1.

Допустимое количество непроплавленных эффектов пайки отдельных выводов одной микросхемы – не более двух.

Способ установки и демонтажа микросхем на платы должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

5.5 Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену необходимо только при отсутствии напряжения на выводах микросхемы.

5.6 Для влагозащиты плат с микросхемами рекомендуется применять лаковое покрытие марки УР-231 ГУ 6-21-14 или ЭП-730 по ГОСТ 20824 в три слоя.

5.7 Разрешается совместная работа микросхем с электрорадиоэлементами и микросхемами других серий при условии соблюдения электрических режимов микросхем, указанных в АБДК 431160.686 тут.